

2SC4238

シリコン NPN エピタキシャルプレーナ形

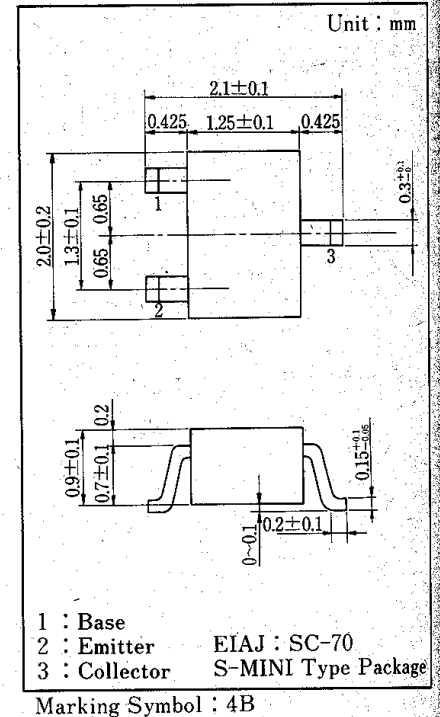
高周波増幅用・発振混合用

■ 特長

- 電力利得 PG が高い。
- トランジション周波数 f_T が高い。
- Sミニ型パッケージのため機器の小形化およびテーピング、マガジン包装による自動挿入が可能。

■ 絶対最大定格 (Ta=25°C)

Item	Symbol	Value	Unit
コレクタ・ベース電圧	V_{CBO}	30	V
コレクタ・エミッタ電圧	V_{CEO}	15	V
エミッタ・ベース電圧	V_{EBO}	3	V
コレクタ電流	I_C	50	mA
コレクタ損失	P_C	200	mW
接合部温度	T_j	150	°C
保存温度	T_{stg}	-55~+150	°C



■ 電気的特性 (Ta=25°C)

Item	Symbol	Condition	min.	typ.	max.	Unit
エミッタしゃ断電流	I_{EBO}	$V_{EB} = 2V, I_C = 0$			2	μA
コレクタ・ベース電圧	V_{CBO}	$I_C = 100\mu A, I_E = 0$	30			V
直流電流増幅率	h_{FE}	$V_{CE} = 10V, I_C = 2mA$	100		350	
コレクタ・エミッタ飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	$I_C = 20mA, I_B = 4mA$			0.5	V
ベース・エミッタ電圧	V_{BE}	$V_{CB} = 10V, I_E = -2mA$		0.7		V
トランジション周波数	f_T	$V_{CB} = 10V, I_E = -15mA, f = 200MHz$	0.8	1.3	1.9	GHz
コレクタ出力容量	C_{ob}	$V_{CB} = 10V, I_E = 0, f = 1MHz$	0.6	1	1.4	pF
帰還容量	C_{rb}	$V_{CB} = 6V, I_E = 0, f = 1MHz$		0.4		pF
電力利得	PG	$V_{CB} = 10V, I_E = -10mA, f = 200MHz$	14	18	22	dB

■ 形名表示記号

